материалы электроники

УДК 546.87 / 86"24:54-165

К. т. н. А. П. АЛИЕВА † , д. т. н. Ф. К. АЛЕСКЕРОВ 2 , к. ф.-м. н. С. Ш. КАХРАМАНОВ 2 , С. А. НАСИБОВА † , Е. Д. МОРОЙДОР 3 , М. ПИШКИН 3

¹Азербайджанский технический университет, ²НПО «Селен» НАН АР, г. Баку, Азербайджан; ³Стамбульский технический университет «Йылдыз», Турция

E-mail: almaz46@mail.ru

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖСЛОЕВЫХ КВАНТОВЫХ НИТЕЙ В ЛЕГИРОВАННОМ ЦИНКОМ ${\rm Bi}_2{\rm Te}_3$

Изучен процесс формирования нанонитей на поверхности (0001) Bi_2Te_3 . Установлено, что в плоскости $Te^{(1)}-Te^{(1)}$ происходит процесс миграции атомов, перемещение и коагуляция кластеров на основе атомов Zn. В результате диффузионно-ограниченной агрегации формируются структуры с квантовыми точками, из которых самоорганизуются нанонити. Такие поверхностные структуры определяют свойства разрабатываемых топологических изоляторов на основе соединений $A_2^{\ VB}_3^{\ VI}$ и увеличивают термоэлектрическую эффективность композита.

Ключевые слова: квантовые точки и нити, миграция атомов, морфология, топологический изолятор, кластеры, диффузия, агрегация.

Слоистые кристаллы $A_2{}^{\rm V}B_3{}^{\rm VI}$ известны как материалы, широко используемые в термоэлектричестве. Обнаруженные в них топологически защищенные состояния выделены в новый вид конденсированного состояния вещества — топологический изолятор, что превратило их в интенсивно исследуемые объекты. Перспектива использования спинового состояния электронов в приповерхностной области этих материалов в качестве носителя единицы информации может стать более доступной при использовании в технологии эффектов самоорганизации наноструктур. Процессы структурной перестройки, протекающие на поверхности кристаллов, играют особую роль при получении систем пониженной размерности, таких как квантовые точки и нити. Примеси определенного вида, не воздействуя радикальным образом на химическую и электронную структуру слоев, выбрасываются в межслоевое пространство, где образуют наноструктуры различной размерности и формы: двумерные — плоскости, одномерные — нити или нульмерные — квантовые точки, которые можно использовать для управления межслоевым расстоянием. Перенос заряда по нитям, плоскостям и туннелирование заряда через квантовые точки соответстуют теории движения жидкости Латтинжера [1, 2], как и краевые состояния квантового спинового эффекта Холла, индуцированные двумерными электронными состояниями, образующимися при раздвижении слоев. Транспорт заряда в объеме слоев имеет характер движения жидкости Ферми. Ранее в [3-6] сообщалось о формировании таких межслоевых наноструктур, как двумерные примесные слои, образующие сверхрешетки и одномерные каналы протекания заряда, и о влиянии их на кинетические параметры. Выстраивание примесных кластеров в массив квантовых точек на поверхности (0001) кристалла яв-

ляется интересным с точки зрения управления свойствами материала.

Целью настоящей работы было изучение процессов формирования межслоевых нанонитей при выстраивании кластеров в плоскости $Te^{(1)}-Te^{(1)}$ на поверхности (0001) слоистого кристалла Bi_2Te_3 , легированного Zn. Исследования проводили посредством атомно-силовой микроскопии (**ACM**) (на сканирующем зондовом микроскопе марки Солвер HEKCT) и рентгенодифрактометрии (на дифрактометре фирмы Philips Panalytical X'Pert Pro XRD).

При проведении исследований изучались следующие вопросы:

- выявление взаимодействия примесей и образования отдельных межслоевых соединений;
- вероятность встраивания агрегированных атомов в разные точки плоскости $Te^{(1)} Te^{(1)}$;
- выявление механизмов роста наночастиц, закономерностей динамики изменения размеров нанообъектов и их распределения при анализе профилограмм;
- выявление самоорганизованных структур, подобных квантовым точкам и нитям.

Установлено, что диффузионные процессы приводят к сближению отдельных малых наночастиц и образованию контактов между ними. Могут взаимодействовать два, три и более нанообразований (квантовых точек). В плоскости $Te^{(1)}-Te^{(1)}$ Bi_2Te_3 формируются нанообъекты различной геометрии, такие как неупорядоченные слоистые структуры и наноостровки, упорядоченные наноступени и наноостровки малых размеров, подобные квантовым точкам, а также упорядоченные линейные фигуры, подобные квантовым нитям. На полученных АСМ-изображениях видны островковые скопления примесей (рис. 1).

материалы электроники



Рис. 1. АСМ-изображение коагулированных наноостровков и нитей в структуре Bi₂Te₃<Zn>

Поскольку цинк относится к примесям, обладающим малым ионным радиусом, при легировании его атомы легко диффундируют в межслоевое пространство халькогенидов висмута и сурьмы. Это подтверждают приведенные АСМфотографии цепочки отдельных наноостровков (рис. 1) и квантовых точек (КТ), сформировавших нанонити.

Миграция и взаимодействие кластеров приводит к образованию квантовых нитей в рамках процесса роста «снизу-вверх». Основной причиной, вызывающей образование напряженных островков на поверхности, является релаксация упругих напряжений на краях слоев и взаимодействие островков посредством напряжений, создаваемых ими в кристалле. Форма КТ может значительно изменяться в процессе заращивания или постростового отжига. На рис. 1 виден конечный результат динамики формирования больших островков из малых и сформированных из КТ линейных образований, которые можно назвать квантовыми нитями. Одна из квантовых нитей сформирована из кластеров высотой до 80 нм и размером у основания порядка 90 нм (рис. 2).

В результате диффузионных процессов в межслоях кристалла $A_2^{\rm V}B_3^{\rm VI}$ формируются нанообъекты различных форм и размеров. При внедрении легкодиффундирующих примесей Cu, Ni, Fe, Zn, Ag, Se происходит двумерный рост, для примесей Sb, In характерен механизм формирования трехмерных нанообъектов. Качественное и визуальное описание морфологических осо-

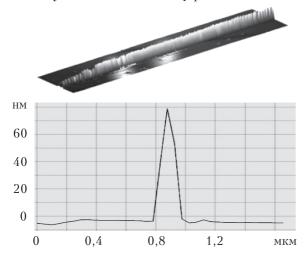


Рис. 2. Изображение нанонити и профилограмма одного из ее поперечных сечений

бенностей самоорганизованных наноразмерных структур выявило степень их упорядоченности. Динамика формирования нанофрагментов такова, что первоначально возникают наноостровки, подобные КТ. В дальнейшем в процессе эволюции островки могут соединяться, образуя перемычки, сохраняя при этом свою форму и высоту, или могут формироваться новые объемные структуры сложной формы. Во всех случаях в качестве характеристического выступает не линейный размер нитей, а размер структурного элемента — подобия квантовой точки, не зависящей от вида примесей.

В процессе самоорганизации в плоскости $Te^{(1)} - Te^{(1)}$ формируется упорядоченный массив наноостровков (квантовых точек). Агрегация частиц приводит к уменьшению плотности распределения КТ и к возникновению нанообъектов больших размеров. Электронно-микроскопические снимки показали, что нанообъекты формируются из наноостровков в процессе диффузии при температурах выше 500 К. Внедряясь главным образом в межслоевое пространство, примеси создают объемные периодические сверхструктуры, состоящие из массивов квантовых точек между слоями теллуридных квинтетов, которые вследствие этого раздвигаются. Усиление анизотропии при самоорганизации КТ приводит к увеличению роли «изгибных» колебаний в упругих колебаниях кристалла, определяющих его тепловые свойства. О роли этой специфической ветви колебаний кристалла, называемых акустическими, и их поведении в слоистых кристаллах согласно теории Лифшица [7] сообщалось в [8]. Изгибная ветвь соответствует колебаниям, распространяющимся в плоскости слоев со смещениями атомов в направлении, перпендикулярном слоям, и дает основной вклад в теплоперенос. Характер температурной зависимости теплоемкости слоистых кристаллов различен в разных диапазонах температуры. Чем больше анизотропия кристалла, тем значительнее роль изгибной ветви в «мембранном» эффекте (росте частоты изгибных колебаний при растяжении слоев), приводящем к отрицательному тепловому расширению в плоскости слоев. Наблюдаемые в настоящих исследованиях аномалии кинетических параметров происходили в области линейного температурного роста теплоемкости кристалла, где доминирует вклад изгибных колебаний. Рассеяние этой фононной ветви у основания КТ, которые химически связаны с теллуридными квинтетами, приводит к термализации уровней КТ с последующим туннелированием заряда. Эта область, в которой теплоемкость пропорциональна квадрату температуры T^2 , а коэффициент теплопроводности про-порционален T^{2+x} (где x может определяться процессами туннелирования, т. е. размерами и плотностью скопления КТ), отмечается как область тепловой аномалии. Отметим, что спад решеточной фононной составляющей теплопроводности в этой области может несколько ком-

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

пенсироваться увеличением электронной составляющей теплопроводности, обусловленной туннельным током, который представляет собой жидкость Латтинжера. Термоэлектрическая эффективность исследуемых образцов выше, чем нелегированных, по-видимому, за счет снижения общей теплопроводности композита «квинтетные слои — нанонити» при увеличении роли рассеяния фононов колебания слоев на границах нанонитей. В этих процессах доминируют фононы, соответствующие изгибным колебаниям, имеющие квадратичный вид дисперсии. Агрегированные структуры, соединенные друг с другом непрерывной цепочкой кластеров, обеспечивают туннелирование заряда по проводящим каналам. Кластеры, формирующие нанонити, уширяют ван-дер-ваальсово пространство, не разрушая топологически защищенные состояния [9], смещают их во внутренний квинтет [10].

Экспериментальный выбор температурного режима отжига легированных кристаллов позволил получить межслоевые наноструктуры требуемой размерности и высотой до 80 нм. Установлено, что миграция и диффузионно-ограниченная агрегация атомов приводит к коагуляции одномерного ряда кластеров на основе атомов Zn, а релаксация упругих напряжений на дефектных центрах и взаимодействие кластеров к формированию нанонитей. Такие поверхностные структуры определяют свойства разрабатываемых топологических изоляторов на основе соединений $A_2^{
m V}B_3^{
m VI}$ и увеличивают термоэлектрическую эффективность композита.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Fogler M. M., Malinin S. V., Nattermann T. Coulomb blockade and transport in a chain of one-dimensional quantum dots // Phys. Rev. Lett. – 2006. – Vol. 97, N 9, P. 096601.

2. Kane C. L., Fisher M. P. A. Thermal Transport in a

Luttinger Liquid // Phys.Rev.Lett. — 1996. — Vol. 76, N 17. —

P. $319\overline{2} - 3195$.

3. Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Кахраманов К. Ш. Межслоевые нанообразования в системе Bi_2Te_3 <Zn> / Сб. Термоэлектрики и их применения.— С-Пб., 2010.— С. 247—252. [Aleskerov F. K., Kakhramanov S. Sh., Kakhramanov K. Sh. // Sb. Termoelektriki i ikh primeneniya. S-Pb., 2010. S. 247]

4. Георгобиани А. Н., Пашаев А. М., Тагиев Б. Г., Алескеров Ф. К., Тагиев О. Б., Кахраманов К. Ш. Процесс роста и самоорганизации нанофрагментов на межслоевых поверта и самоорганизации напофрагментов на межсловых повержностях слоистых кристаллов A^VB^{VI} / Неорган. материалы. — 2011. — Т. 47, № 12, С. 1447—1452. [Georgobiani A. N., Pashaev A. M., Tagiev B. G., Aleskerov F. K., Tagiev O. B., Kakhramanov K. Sh. // Neorgan. materialy. 2011. Vol. 47, N 12, P. 1447]

5. Алескеров Ф. К., Кахраманов К. Ш., Кахраманов С. Ш. Перколяционный эффект в кристаллах $\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Te}_{3}$, легированных медью или никелем // Неорган. материалы. — 2012. — Т. 48, № 5, С. 536—541. [Aleskerov F. K., Kakhramanov K. Sh., Kakhramanov S. Sh. // Neorgan. materialy. 2012. Vol. 48, N 5, P. 536]

6. Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Дерун Е. М. и др. Некоторые особенности формирования нанообъектов в межслоевом пространстве кристаллов типа Bi₂Te₃ // Fizika, Azerbaycan. — 2007. — Т. XIII, № 4. — С. 41—45. [Aleskerov F. K., Kakhramanov S. Sh., Derun E. M. i dr. // Fizika, Azerbaycan. 2007. Vol. XIII, N 4. P. 41] 7. Лифшиц И. М. О тепловых свойствах цепных и слоис-

тых структур при низких температурах // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1952. — Т. 22, вып. 4.

C. 475—486. [Lifshits I. M. O teplovykh svoistvakh tsepnykh i sloistykh struktur pri nizkikh temperaturakh // Zhurnal eksperimental'noi i teoreticheskoi fiziki. 1952. Vol. 22. Iss. 4. P. 475]

8. Абдуллаев Н. А., Сулейманов Р. А., Алджанов М. А.,

Алиева Л. Н. О роли изгибных колебаний в процессах тепло-Алиева Л. Н. О роли изгионых колеоании в процессах тепло-переноса в слоистых кристаллах // Физика твердого тела. — 2002. — Т. 44, № 10. — С. 1775—1779. [Abdullaev N. A., Suleimanov R. A., Aldzhanov M. A., Alieva L. N. // Fizika tverdogo tela. 2002. Vol. 4, N 10. S. 1775] 9. Kundu A., Zazunov A., Yeyati A. L. et al. Energy spectrum and broken spin-surface locking in topological insulator

quantum dots // Phys. Rev. B.— 2011.— Vol. 83, N 12.-

P. 125429.

10. Меньшикова Т. В., Еремеев С. В., Чулков Е. В. О происхождении состояний двумерного электронного газа на поверхности топологических изоляторов // Письма в ЖЭТФ. — 2011. — Т. 94, № 2. — С. 110—115. [Men'shikova T. V., Eremeev S. V., Chulkov E. V. // Pis'ma v ZhETF. 2011. Vol. 94, N 2. P. 110]

> Дата поступления рукописи в редакцию 31.01 2012 г.

Alieva A. P., Aleskerov F. K., Kakhramanov S. Sh., Nasibova S. A., Moroidor E. D., Pishkin M. The mechanism of formation of the interlayer quantum wires in zinc-doped Bi₂Te₃.

Keywords: quantum dots, nanowires, migration of atoms, morphology, topological insulators, clusters, diffusion, aggregation.

Nanowires formation process on a (0001) surface of Bi_2Te_3 is studied. It has been established that on interlayer surface $Te^{(1)}-Te^{(1)}$ there is a process of migration of atoms, moving and coagulation of clusters on the basis of Zn atoms. As a result of diffusion-limited aggregation the structures with quantum dots are formed, from which nanowires are self-organized. Such superficial structures play regulating role in working out the topological insulators based on $A_2^{\text{V}}B_3^{\text{VI}}$ and increase thermoelectric efficiency of a composite.

Azerbaijan Technical University, the NGO «Selen» NAS RA, Baku, Azerbaijan; Istanbul Technical University "Yildiz", Turkey.

Алієва А. П., Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насібова С. А., Моройдор Є. Д., Пішкін М. Механізм формування міжшарових квантових ниток в легованому цинком Bi_2Te_3 .

Ключові слова: квантові точки та нитки, міграція атомів, морфологія, топологічний ізолятор, кластери, дифузія, агрегація.

Вивчено процес формування нанониток на поверхні (0001) Ві $_2$ Те $_3$. Встановлено, що у площині Те $^{(1)}$ — Те⁽¹⁾ відбувається процес міграції атомів, переміщення і коагуляція кластерів на основі атомів Zn. В результаті дифузійно-обмеженої агрегації формуються структури з квантовими точками, з яких самоорганізуються нанонитки. Такі поверхневі структури відіграють регулюючу роль при розробці топологічних ізоляторів на основі сполук $A_2^{\vec{\mathsf{V}}}B_3^{\mathsf{VI}}$ і збільшують термоелектричну ефективність композиту.

Азербайджанський технічний університет, НВО «Селен» НАН АР, Баку, Азербайджан; Стамбульський технічний університет «Йилдиз», Туреччина.